

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Скворцов Аркадий Алексеевич
2	Дата рождения (полная)	02.11.1968
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук (специальность 01.04.04 – «Физическая электроника»)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	107023, Москва, ул. Большая Семеновская, 38 mospolytech.ru mospolytech@mospolytech.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет"
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Автономное учреждение
	Наименование подразделения	Научно-технический центр "Оптоэлектроника"
	Должность	Старший научный сотрудник
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<ol style="list-style-type: none"> Manyakhin F.I., Varlamov D.O., Morketsova L.O., Skvortsov A.A., Nikolaev V.K. Influence of the nature of the distribution of recombination centers in the space charge region of the p–n junction on the parameters of the current–voltage characteristics within the classical Shockley and Shockley–Noyce–Sah models // Semiconductor Science and Technology. – 2025. – Т. 40. – № 1. – P. 015017. DOI 10.1088/1361-6641/ad929e. Manyakhin F.I., Mokretsova L.O., Skvortsov A.A., Varlamov D.O. Electrophysical reasons for limiting the operating modes of quantum well light emitting diodes // Light & Engineering. – 2025. – Т. 33. – № 4. – P. 103–112. DOI 10.33383/2025-11. Скворцова А.А., Волкова Л.В., Каленков С.Г., Скворцов А.А. Оценка влияния постоянного магнитного поля на люминесценцию кристаллов фосфида галлия // Оптический журнал. – 2025. – Т. 92. – № 5. – С. 50–56. Kulchin Yu.N., Skvortsov A.A., Nikolaev V.K., Volodina O.V. Development of thermal memory cells on silicon using the floating zero algorithm // Scientific Reports. – 2025. – Т. 15. – № 1. – P. 5184. DOI 10.1038/s41598-025-89566-0. Волкова Л.В., Каленков С.Г., Скворцова А.А., Николаев В.К., Скворцов А.А. Влияние внешнего магнитного поля на люминесценцию кристаллов фосфида галлия // Письма в журнал технической физики. – 2025. – Т. 51. – № 3. – С. 17–20. DOI 10.61011/PJTF.2025.03.59814.20097 Manyakhin F.I., Varlamov D.O., Krylov V.P., Morketsova L.O., Skvortsov A.A., Nikolaev V.K. Physico–mathematical model of the voltage–current characteristics of light-emitting diodes with quantum wells based on the Sah–Noyce–Shockley recombination mechanism // Journal of Semiconductors. – 2024. – Т. 45. – № 8. – P. 082102. DOI 10.1088/1674-4926/23120044 	

	<p>7. Varlamov D.O., Manyakhin F.I., Skvortsov A.A. The interrelation between temperature and power supply modes of low power high efficiency light emitting diodes // Light & Engineering. – 2023. – Т. 31. – № 3. – Р. 91–99. DOI 10.33383/2022-048.</p> <p>8. Skvortsov A.A., Varlamov D.O., Nikolaev V.K., Volodina O.V., Skvortsova A.A. Shock-wave processes in the electric explosion of thin-film systems on silicon // Silicon. – 2023. – Т. 15. – № 4. – Р. 1987–1992. DOI 10.1007/s12633-022-02147-y.</p> <p>9. Корячко М.В., Скворцов А.А., Пшонкин Д.Е., Володина О.В. Анализ процесса разрушения алюминия на поверхности кремния при электрическом взрыве проводника // Письма в журнал технической физики. – 2022. – Т. 48. – № 9. – С. 3–6. DOI 10.21883/PJTF.2022.09.52441.19114.</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты